C'd PCT/PTO 03 JUN 2005

特 許 協 力 全 約

REC'D	2 4	SEP	2004
WIPO			PCT

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の 咨 類記号 NE-70124WO				今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP03/15415			3/15415	国際出願日 (日.月.年) 0	2. 12	. 03	優先日 (日.月.年)	03.	1 2.	0 2
国際	国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L33/00, H01S5/343									
出顧	出願人(氏名又は名称) 日本電気株式会社									
1.	一									
	この国際予備審査報告には、附属審類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細事、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属審類は、全部で ページである。									
3.	Ξ σ.	_	予備審査報告は、次の内容	を含む。						٠.
	I	X	国際予備審査報告の基礎				•			
	Ⅱ □ 優先権									
	Ⅲ									
	IV 開の単一性の欠如									
,	V 図 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 Ⅵ □ ある種の引用文献									
	VII 国際出願の不備									
	VII 国際出願に対する意見									
				·						
国際予備審査の請求費を受理した日 02.12.03 国際予備審査報告を作成した日 06.09.04										
名称及	名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)			特許庁	審査官(権限の)ある職員)		2 K	8422	
郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号				近藤幸浩 (上海) 印						
		пр			電話番	号 03-35	81-110	L 内紹	泉 :	3 2 5 3





国際出願番号 PCT/JP03/15415

I.	1	国際予備審查幸	吸告の基礎	1		<u> </u>		
1.	,	この国際予備領 応答するために P C T 規則70.	に従用され	ルた達し替え用紙	に基づいて作成さ は、この報告ชに	れた。 (法第6条 (P おいて「出願時」とし	CT14条)の規定に基づく命令に 、本報告書には添付しない。	
	X	出願時の国際	禁出願也類	i				
		明細書 明細書 明細書	第 第 第		ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出された 国際予備審査の請求	もの 啓と共に提出されたもの 付の啓簡と共に提出されたもの	
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第		項、 項、 項、 項、	出願時に提出された PCT19条の規定 国際予備審査の請求:	もの に基づき補正されたもの 暋と共に提出されたもの 付の番簡と共に提出されたもの	
		図面 図面	第 第 第		ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、		もの 唐と共に提出されたもの 付の 魯簡と共に提出されたもの	
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	l表の部分 l表の部分	第 第	ページ、 ページ、 ページ、		客と共に提出されたもの 付の魯簡と共に提出されたもの	
2.						の国際出願の言語である	3.	
	上記の書類は、下記の官語である 語である。 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の官語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の官語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の官語							
3.	٤ .	の国際出願は	:、ヌクレ:	オチド又はアミノ	/ 酸配列を含んで	おり、次の配列表に基っ	づき国際予備審査報告を行った。	
	□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された審面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。							
4.	# 	請求の範囲	Arte	が削除された。	-	· 2/図		
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)								
						•		

		DWHMME 7 FCI	/JP03/15415
V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に 文献及び説明	ついての法第129	ト (PCT35条(2)) k	こ定める見解、それを裏付ける
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-15	·
進歩性(IS)	簡求の範囲 請求の範囲	11-15 1-10	
・ 産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 ₋ 請求の範囲 ₋	1-15	
2. 文献及び説明(PCT規則70.7)		·	
以下の文献はいずれも国際調査幸	限告で引用され	ぃたものである。	
文献1:GB 2323210 A 文献2:JP 2002-185085 A	(Hewlett-Pa (シャープ株	ckard Company) 式会社)	1998. 09. 16 2002. 06. 28
・請求の範囲1-10について	•		
東京13-26年 1(特別 1) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	なけず 大きに はないによいにない 大きない 大きない 大きないいっこう 大きないいっこう はんかい 大きないいっこう はんかい かられる では、 こびるて子認不ド造献いる できます いっこう イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下では、 ないした対したがすれび とプ内をいしを均るドる物2 しすの均で、導一。一こをの では、は、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では	たは濃 一濃導と物文で含ドらは明度 プ度体いを献・すーはいまな物 な均子一入に・記し純がれて こに造的な「とでいをがっていす とす例半とな載ると一プいす とす例半とな載るとしまないを がるえ がるえ 過ぎくさこがに しょう
なお、文献1及び2には、本願明 長させることも記載されているが、 困難であるのか否かは、本願明細書		一方生に トニケル・	E等の方法により成 均一なドーピングが

また、成長の下地となる基板に窒化物半導体基板を用いることは文献2(例えば段落0012の記載)に示されており、成長の下地となる窒化物半導体基板の表面転位密度が低いことが好ましいことは当業者に明らかである。そして、窒化物半導体基板の表面転位密度を請求の範囲3及び4に記載された値とすることは普通に選択される値と認められる。基板と発光層の間に第4B族元素を不純物として含む半導体層を設けることも文献2(例えば段落0012-0013の記載;SiH4の供給)に示されている。また、発光層を構成する量子井戸構造の障壁層にInを含ませることは文献2(特に段落0014の記載)に示されている。



補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 棚の続き

また、請求の範囲8及び9にそれぞれ記載された発光層の不純物濃度及びキャリア濃度は、当業者が試験測定など通常の技術的活動を通じて適宜設定しうる程度の値と認められる。

・請求の範囲11-15について

請求の範囲11-15に記載された発明は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者に自明なものでもない。